

TDS:EMIC

拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障

WEB | WWW.TDSEMIC.COM



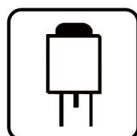
電源管理



顯示驅動



二三極管



LDO穩壓器



觸摸芯片



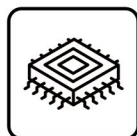
MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

DW01-TD

產品規格說明書

DW01 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

功能特点

- 1) 高精度电压检测功能：
 - 过充电检测电压 4.280V
 - 过充电恢复电压 4.080V
 - 过放电检测电压 2.400V
 - 过放电恢复电压 3.000V
- 2) 放电过电流检测功能：
 - 过电流检测电压 0.150V
 - 短路检测电压 1.000V
- 3) 充电过流检测电压 -0.150V
- 4) 负载检测功能
- 5) 充电器检测功能
- 6) 0V 充电功能
- 7) 过放自恢复功能
- 8) 低电流消耗：
 - 工作模式 1.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
 - 过放电时耗电流 (有过放自恢复功能) 0.7 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
- 9) 无铅、无卤素。

应用领域

- 锂离子可充电电池

封装

- SOT23-6

系统功能框图

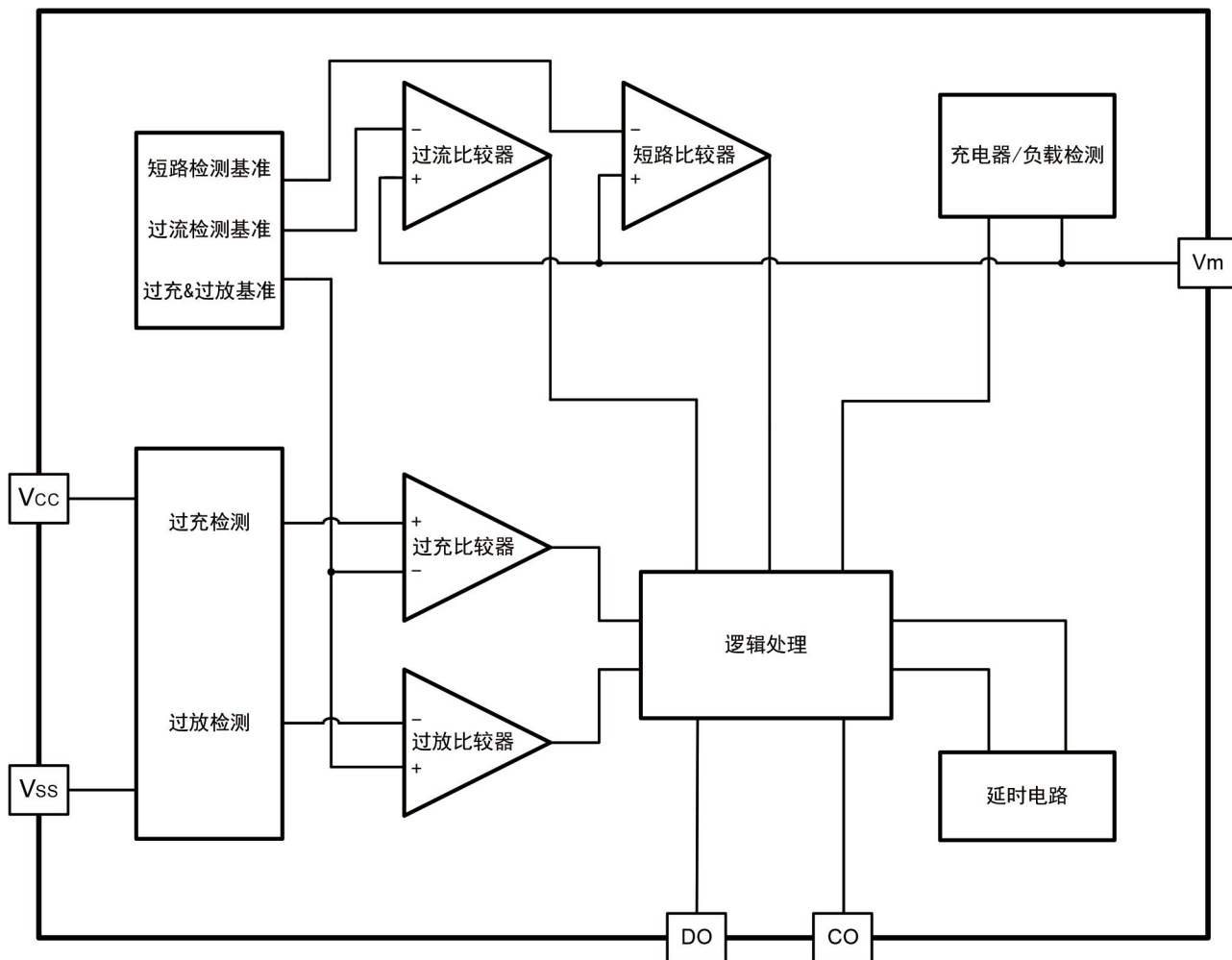


图 1

产品型号

参数 产品名	过充电 保护电压 Voc	过充电 解除电压 VOCR	过放电 保护电压 VOD	过放电 解除电压 VODR	放电 过流 VEC1	短路 VSHORT	充电过电流 VCHA	过充 锁定	过放 锁定
DW01	4.280 V	4.080 V	2.400 V	3.000 V	0.150 V	1.000 V	-0.150 V	Y	N

表 1

引脚排列图

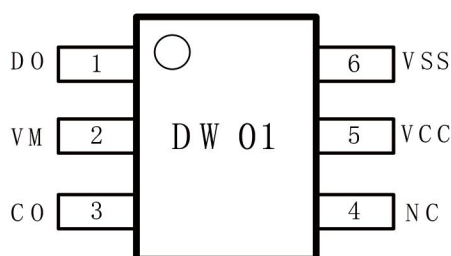


图 2

引脚号	符号	描述
1	DO	放电 MOSFET 控制端子
2	VM	充放电电流检测端子
3	CO	充电 MOSFET 控制端子
4	NC	未连接
5	VCC	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
6	VSS	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连

表 2

绝对最大额定值

(除特殊注明以外：Ta = +25°C)

项目	符号	适用端子	绝对最大额定值	单位
电源电压	VCC	VCC	-0.3 ~ 6	V
VM 端输入电压	VM	VM	VCC-15 to VCC+0.3	V
工作环境温度	T _{OPR}	-	-40 ~ 85	°C
保存温度	T _{STG}	-	-55 ~ 125	°C

表 3

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

电气特性

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C,)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
芯片电源电压	VCC	-	1.0	-	5.5	V	
正常工作电流	I _{VCC}	VCC=3.5V	-	1.5	5.0	μA	
过放电时消耗电流	I _{OPED}	VCC =1.5V	-	0.7	1.5	μA	
过充电	保护电压	V _{OC}	VCC =3.5→4.5V	4.230	4.280	4.330	V
	解除电压	V _{OCR}	VCC =4.5→3.5V	4.030	4.080	4.130	V
	保护延时	T _{OC}	VCC =3.5→4.5V		80	160	ms
过放电	保护电压	V _{OD}	VC5=3.5→2.0V	2.300	2.400	2.500	V
	解除电压	V _{ODR}	VCC =2.0→3.5V	2.900	3.000	3.100	V
	保护延时	T _{OD}	VCC =3.5→2.0V		40	80	ms
放电过流	保护电压	V _{EC}	VM-VSS=0→0.20V	0.120	0.150	0.180	V
	保护延时	T _{EC}	VM-VSS=0→0.20V		10	20	ms
充电过流	保护电压	V _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	-0.180	-0.150	-0.120	V
	保护延时	T _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V		10	20	ms
短路	保护电压	V _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	0.700	1.000	1.300	V
	保护延时	T _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V		300	600	μs
0V 充电充电器起始电压	V _{OVCH}	允许向 0V 电池充电功能	1.2	-	-	V	

表 4

功能说明

1. 过充电状态

电池电压上升到 V_{OC} 以上并持续了一段时间 T_{OC} ，CO 端子的输出就会反转，将充电控制 MOS 管关断，停止充电，这就称为过充电状态。电池电压降低到过充电解除电压 V_{OCR} 以下并持续了一段时间 T_{OCR} ，就会解除过充电状态，恢复为正常状态。

进入过充电状态后，要解除过充电状态，恢复到正常状态，有两种方法：

- 1) 断开充电器，不连接负载且 $V_{CHA} < V_{VM} < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压 V_{OCR} 以下时，过充电状态就会释放
- 2) 断开充电器，连接负载，如 $V_{VM} > V_{EC}$ ，此时只需 $V_{CC} < V_{OC}$ ，过充电状态就会释放，此功能称作负载检测功能。

注意：检测到过充电后，如果一直连接充电器，那么即使电芯电压降低到 V_{OCR} 以下，过充电状态也无法释放。通过断开充电器连接，且 $V_{M} > V_{CHA}$ 才能解除过充放电状态。

2. 过放电状态

电池电压降低到 V_{OD} 以下并持续了一段时间 T_{OD} ，DO 端子的输出就会反转，将放电控制 MOS 管关断，停止放电，这就称为过放电状态。电池电压上升到过放电解除电压 V_{ODR} 以上并持续了一段时间 T_{ODR} ，就会解除过放电状态，恢复为正常状态。

进入过放电状态后，要解除过放电状态，恢复正常状态，有三种方法：

- 1) 连接充电器，若 VM 端子电压低于充电过流检测电压(V_{CHA})，当电池电压高于过放电检测电压(V_{OD})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称作充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 VM 端子电压高于充电过流检测电压(V_{CHA})，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 没有连接充电器时，如果电池电压自恢复到高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态

3. 放电过流状态

电池处于放电状态时，VM 端电压随着放电电流的增大而增大，当 VM 端电压高于 V_{EC} 并持续了一段时间 T_{EC} ，芯片认为出现了放电过流；当 VM 端电压高于 V_{SHORT} 并持续了一段时间 T_{SHORT} ，芯片认为出现了短路。上述 2 种状态任意一种状态出现后，DO 端子的输出就会反转，将放电控制 MOS 管关断，停止放电。

只要负载等效阻值变大或断开负载，使 $V_{M} < V_{EC}$ ，即可解除放电过流状态，恢复正常状态。

4. 充电过流检测

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果 VM 端子电压低于充电过流检测电压(V_{CHA})，并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间(T_{CHA})，则关闭充电控制用的 MOSFET，停止充电，这个状态称为充电过流状态。进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使 VM 端子电压高于充电过流检测电压(V_{CHA})时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

5. 0V 充电功能

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极(P+)和电池负极(P-)之间的充电器电压，高于向 0V 电池充电的充电器起始电压(V_{0VCH})时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位，由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压，充电控制用 MOSFET 导通(CO 端子打开)，开始充电。这时，放电控制 MOSFET 仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压(V_{OD})时，IC 进入正常工作状态。

应用电路

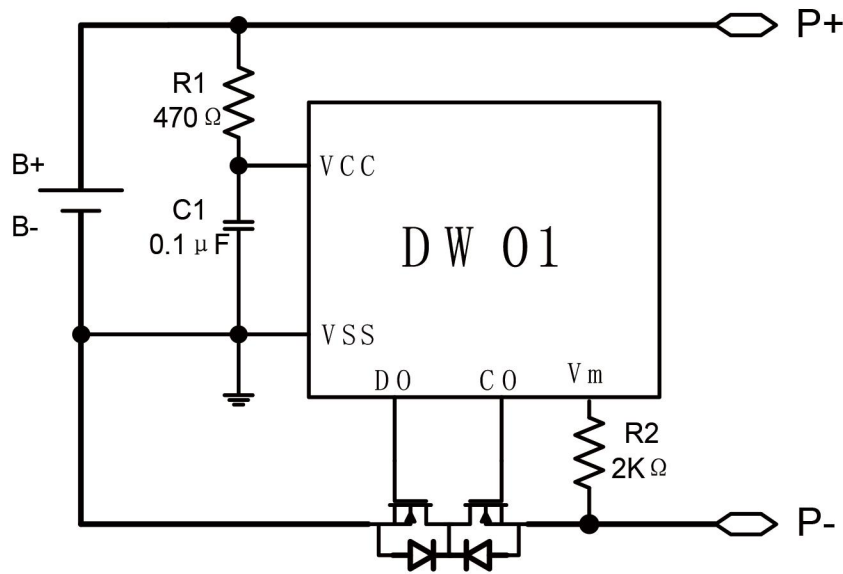


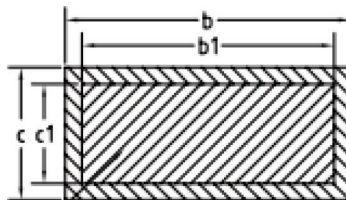
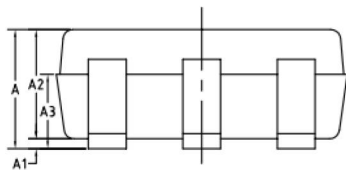
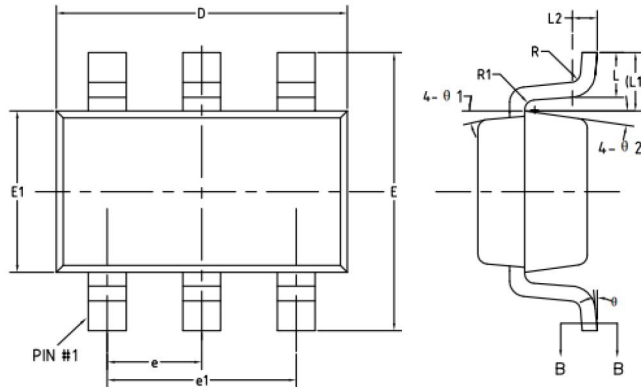
图 3

器件标识	典型值	参数范围	单位
R ₁	470	470 ~ 1500	Ω
R ₂	2	1 ~ 3	kΩ
C ₁	0.1	≥ 0.1	μF

注意：R₁，R₂ 不可省略，且 R₁ 必须大于或等于 470 欧。

封装信息

SOT23-6 封装尺寸



BASE METAL
SECTION B-B

COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.45
A1	0	—	0.15
A2	0.90	1.15	1.30
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	—	0.49
b1	0.35	0.40	0.45
c	0.08	—	0.22
c1	0.08	0.13	0.20
D	2.80	2.90	3.00
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.35	0.45	0.60
L1	0.35	0.60	0.85
L2	0.25BSC		
R	0.10	—	—
R1	0.10	—	0.25
θ	0°	—	8°
θ 1	7°	9°	11°
θ 2	8°	10°	12°

NOTES:

ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MO-178 C
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.